

□ KT667A9

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* универсальный. Предназначен для применения в генераторах отклонения передающих телевизионных камер высокой четкости на трубках с дефлекторной системой отклонения. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Габаритный чертеж транзистора аналогичен приведенному для транзисторов 2Т664А9, 2Т664Б9. Масса транзистора не более 0,1 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_э = 5$ мА, не менее	50
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10$ В, $I_к = 1,5$ мА, не менее	40 МГц
Граничное напряжение при $I_к = 30$ мА, не менее	250 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 10$ мА, $I_б = 2$ мА, не более	1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 300$ В, не более	0,1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5$ В, не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	300 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм	300 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 500$ мкс	50 мА
Постоянный ток базы	5 мА
Импульсный ток базы при $t_{и} = 500$ мкс	10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
с теплоотводом ¹ при $T_к = -6 \dots +25^\circ\text{C}$	1 Вт
без теплоотвода ² при $T = -60 \dots +25^\circ\text{C}$	0,3 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C

Тепловое сопротивление переход-корпус	125°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	416°C/Вт
Температура окружающей среды	-60...+100°C

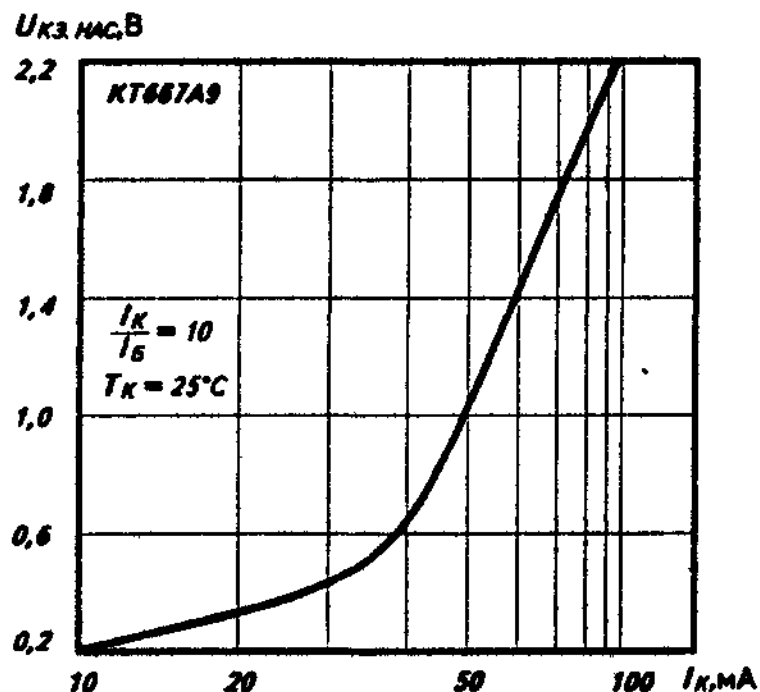
¹ При $T_к > +25^\circ\text{C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, \text{ макс}} = (150 - T_к) / 125, \text{ Вт}$$

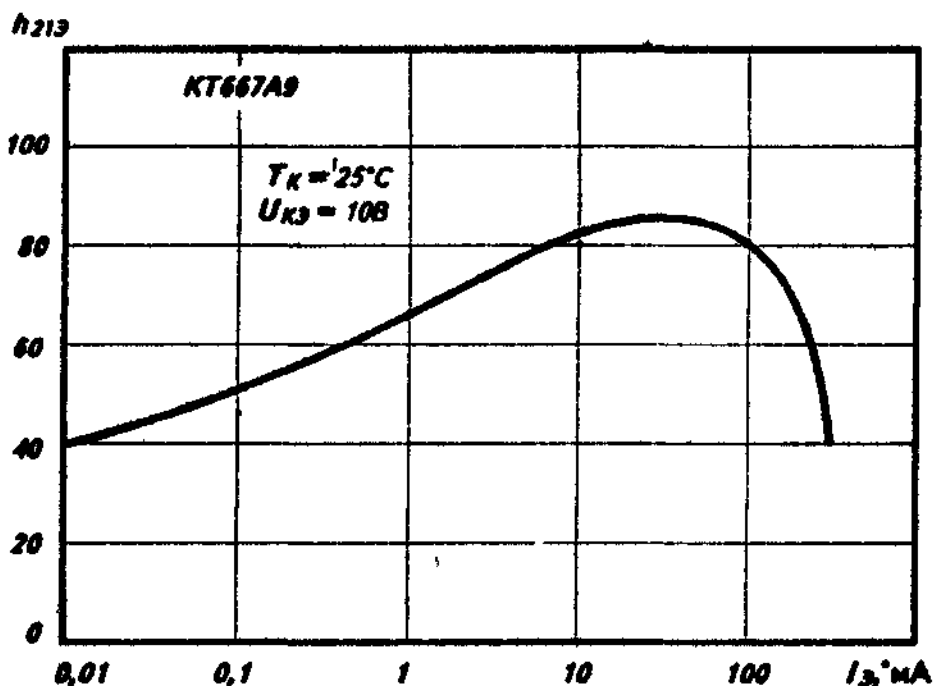
² При $T > +25^\circ\text{C}$

$$P_{к, \text{ макс}} = (150 - T) / 416, \text{ Вт}$$

Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев на расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзистора, время пайки не более 4 с, температура пайки не более +265°C.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.